









	<p><b>SI8902EDB-T2-E1</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI8902EDB-T2-E1</p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 20V 3.9A 6-MFP</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI8902EDB-T2-E1.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 164438 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI8902EDB-T2-E1
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 3.9A 6-MFP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	164438 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1W
Verpackung / Gehäuse	6-MICRO FOOT@CSP
Supplier Device-Gehäuse	6-Micro Foot™
Typ FET	2 N-Channel (Dual) Common Drain
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.9A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	-
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 980µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	-
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI8902EDB-T2-E1 ist neu im Original, Suche SI8902EDB-T2-E1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI8902EDB-T2-E1 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI8902EDB-T2-E1: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI8902EDB-T2-E</b> VISHAY SI8902EDB-T2-E VISHAY</p>	 <p><b>SI8902EDB</b> VISHAY SI8902EDB VISHAY</p>	 <p><b>SI8902EDB-T2-E1</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 3.9A 6-MFP</p>	 <p><b>SI8902D-A01-GSR</b> Energy Micro (Silicon Labs) IC ADC 10BIT SPI/SRL SOIC</p>
 <p><b>SI8920AC-IP</b> Energy Micro (Silicon Labs) IC OP AMP ISOLATION 8DIP-GW</p>	 <p><b>SI8904EDB-T2-E1</b> Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 3.8A 6-MFP</p>	 <p><b>SI8904EDB-T2-E1</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 3.8A 6-MFP</p>	 <p><b>SI8902D-A01-GS</b> Energy Micro (Silicon Labs) IC ADC 10BIT SPI/SRL SOIC</p>

heiße Teile

Mehr

- |                  |                   |                   |                   |                   |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ⊗ SI8640EC-B-IS  | ↔ SI8640ED-B-IS   | ↔ SI8641BB-B-IS   | D SI8641BC-B-IS   | ↔ SI8641BD-A-ISR  |
| ⊣ SI8641BD-B-IS  | ⊗ SI8641BD-B-ISR  | D SI8641EC-B-IS   | ↔ SI8641ED-B-IS   | ↔ SI8641ED-B-ISR  |
| ⊗ SI8642AB-B-ISR | ⊣ SI8642BC-B-IS1  | ⊗ SI8645BB-B-IS   | ↔ SI8645BC-B-IS   | ↔ SI8645BD-B-IS   |
| D SI8660AB-B-IS1 | ⊗ SI8660BA-A-IS1R | ⊣ SI8661BD-B-ISR  | ⊗ SI8662AB-B-IS1  | ↔ SI8662BC-A-IS1R |
| ↔ SI8710AC-B-IS  | ↔ SI8710AD-B-IS   | ⊗ SI8710BD        | ⊣ SI8710CC-B-IP   | ↔ SI8710CC-B-IS   |
| ↔ SI8710CD-B-IS  | ↔ SI8710CD-B-ISR  | D SI8711CC-B-IS   | ⊗ SI8712AC-B-IS   | ⊣ SI8716BC        |
| ⊗ SI8716BC-A-IS  | D SI8719BD-A-IS   | ↔ SI8800EDB-T2-E1 | ↔ SI8800EDB-T2-E1 | ↔ SI8802DB-T2-E1  |
| ⊣ SI8802DB-T2-E1 | ⊗ SI8808DB-T2-E1  | ↔ SI8808DB-T2-E1  | ↔ SI8812DB-T2-E1  | ↔ SI8812DB-T2-E1  |
| ⊗ SI8901EDB-T2   | ⊣ SI8901EDB-T2-E1 | ⊗ SI8901EDB-T2-E1 | D SI8902EDB       | ↔ SI8902EDB-T2    |
| ↔ SI8902EDB-T2-E | ⊗ SI8902EDB-T2-E1 | ⊣ SI8920AC-IP     | ⊗ SI8920BC-IPR    | ↔ SI8920BC-IPR    |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited